PASJ2016 MOP052

医療サイクロトロン用大電流負イオン源の開発

DEVELOPMENT OF A HIGH CURRENT NEGATIVE ION SOURCE FOR MEDICAL CYCLOTRONS

衞藤晴彦^{#, A)}, 荒川慶彦^{A)}, 青木康^{A)}, 三堀仁志^{A)}, 櫻庭順二^{A)}, 加藤隆典^{A)}, 密本俊典^{A)}, 矢島暁^{A)}, 尾内杜彰^{B)}, 畑山明聖^{B)}, 奥村義和^{C)}

Haruhiko Etoh ^{#, A)}, Yoshihiko Arakawa^{A)}, Yasushi Aoki^{A)}, Hitoshi Mitsubori^{A)}, Junji Sakuraba^{A)}, Takanori Kato^{A)},

Toshinori Mitsumoto^{A)}, Satoru Yajima^{A)}, Moriaki Onai^{B)}, Akiyoshi Hatayama^{B)}, Yoshikazu Okumura^{C)}

^{A)} Sumitomo Heavy Industries, Ltd.

^{B)} Graduate School of Science and Technology, Keio University

^{C)} National Institute for Quantum and Radiological Science and Technology

Abstract

A filament driven multi-cusp negative hydrogen ion source has been developed for proton cyclotrons in medical application. In Cs-free operation, there is an optimum magnetic filter field which makes the H⁻ current maximum. Continuous H⁻ beam of 15 mA is obtained at an arc power of 6.5 kW. In Cs-seeded operation, continuous H⁻ beam of 21 mA was stably extracted at a constant arc power of 2.5 kW over 2 hours with the plasma electrode made of molybdenum.

1. はじめに

ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)や核医学診断用放射 性同位体(RI)製造に用いられる医療用陽子サイクロトロ ンのビーム大電流化を目的として,住友重機械工業(株) では大電流水素負イオン源の開発を進めている.

BNCT は、がん細胞内に取り込まれたホウ素と体外か ら照射された中性子との反応を利用し,細胞レベルでの 選択的ながん治療を可能とすることから,難治性がんに 対する画期的な治療法として期待されている. BNCT に 必要な中性子の照射時間は現状のシステムでは最長1 時間程度と長く、中性子の発生量を増加させることに よって治療時間の短縮が望まれる. BNCT 用の加速器 中性子源として供されるサイクロトロンは負イオン加速型 であり、イオン源は大電流の DC ビーム出力が要求され るため、 負イオン源をサイクロトロン本体の外に設置した 外部負イオン源を使用している. イオン源から引き出され る負イオンビーム電流は、サイクロトロンからの陽子ビー ム電流と最終的に生成される中性子量を決定する重要 な因子であり、イオン源の大電流化が BNCT 治療時間 の短縮実現に繋がる. 医療用 RI 製造においても BNCT 同様に負イオン加速型サイクロトロンが用いられており, RIの大量製造には大電流負イオン源が不可欠である.

これまでの開発により、負イオン源から定常で 10 mA, 30 keV の水素負イオン(H⁻) DC ビームと、3.3 mA, 16 keV の重水素負イオン(D⁻) DC ビームの引き出しを達成 した. さらにプラズマ中へのセシウム(Cs) 導入によって、 22 mA まで H⁻ビーム電流を増大可能であることを確認し た[1]. 本稿では、Cs を導入しない場合の H⁻ビーム電流 のフィルター磁場依存性と、Csを導入した場合のH⁻ビー ム電流の連続引出し試験結果について報告する. 開発した負イオン源の断面構造を Figure 1 に示す. プ ラズマチャンバーは内径 98 mm,長さ 160 mm の銅製円 筒であり,内部に 2 本のアーチ型タングステンフィラメント を設置している.フィラメントとチャンバー内壁との間で DC アーク放電を起こすことで,水素プラズマを生成する. プラズマはチャンバー外壁に取り付けられた永久磁石に よるマルチカスプ磁場で閉じ込められる.電極は上流側 からプラズマ電極,引出電極,接地電極の三段構成であ り,いずれも銅製である.プラズマ電極の引出孔径は ¢ 13mm である.負イオンとともに引き出される電子は引出 電極内部に埋め込まれた永久磁石の磁場によって負イ オンビーム軌道から除去している.

負イオンの生成過程には体積生成過程と表面生成過 程があり,体積生成過程は以下に示す二段階の反応で 構成される[2].

(a) $H_2(v) + e \rightarrow H_2(v') + e$

(b)
$$H_2(v') + e \rightarrow H + H^-$$

反応(a)は水素分子と高エネルギー電子(数+ eV)と の衝突による振動励起水素分子の生成過程であり,反 応(b)は振動励起水素分子と低エネルギー電子(~1 eV) の解離性付着反応による負イオンの生成過程である.反 応(a)(b)は異なる電子エネルギー依存性を持つため, 体積生成型の負イオン源ではフィルター磁場によってプ ラズマチャンバー内部を高エネルギー電子領域と低エネ ルギー電子領域の2つの領域に分割する方法が一般的 である[3].したがって,本負イオン源においてもマルチ カスプ永久磁石の一部の極性を変えることで,プラズマ 電極近傍にプラズマチャンバー中心軸を横切るように フィルター磁場を形成している.

一方, 表面生成過程では Cs が付着することによって

^{2.} DC 負イオン源の構造および動作原理

[#] haruhiko.etoh@shi-g.com

PASJ2016 MOP052

低仕事関数となったプラズマ電極表面が水素原子を負 イオン化する現象を利用し,体積生成型負イオン源の チャンバー内部へ Cs を導入することで負イオン生成量 が数倍に増加することが知られている[4,5,6].そこで本 負イオン源では,イオン源外部に設置された Cs 導入器 を通じてフィラメント取り付けフランジ中央部から Cs を導 入可能な構造としている.また,Cs を導入する場合は, プラズマ電極温度を高温にするために,銅製電極からモ リブデン製電極に変更している.

プラズマ電極引出孔から 370mm 下流にファラデー カップを設置しており、ここで負イオン源から引き出され たビーム電流を計測している.



Figure 1: Schematic diagram of the source.

3. 負イオンビーム電流のフィルター磁場依 存性

イオン源プラズマにCsを導入した状態では,Hビーム 電流を2倍以上に増大できるという利点があるが[1],Cs 導入器を含む制御対象の追加,およびCsの補充・交換 や機器の洗浄といった作業が必要となるといった理由か ら,制御と保守が複雑化する.Csを導入しない状態で は,イオン源の取扱いは簡単となるものの,高アークパ ワーでビーム電流が飽和する[7].

ビーム電流のアークパワー依存性はフィルター磁場強度に影響を受けることから、Csを導入しない状態で生成可能な負イオン量の限界を調べるため、磁場強度の異なる6種類のフィルター磁石A~Fを用意し、それぞれの磁場条件において得られる最大ビーム電流を比較した.Figure 2 に、6種類のフィルター磁場のイオン源中心軸上における磁場分布を示す.横軸ZはFigure 1 に示すようにプラズマ電極表面からの距離である.

各フィルター磁場条件における最大ビーム電流と,最 大ビーム電流が得られたときのアークパワーを,横軸を フィルター磁場強度のピーク値としてプロットした結果を Figure 3 に示す.

A~F のうちビーム電流が最大となるのは D, E で, 15 mA のビーム電流が得られた.しかしながら, 6.5 kW 程度のアークパワーが必要であり, アーク効率(ビーム電流とアークパワーの比)は悪い.これに対してCでは14mA のビームがアークパワー4.4 kW で得られており, アーク効率は最大となることから, フィラメントの延命といった実用的観点から望ましい条件であるといえる.



Figure 2: Magnetic filter field on the centerline of the chamber.



Figure 3: H⁻ beam current and arc-discharge power at each magnetic filter field strength.

4. Cs 導入による 20 mA ビーム引き出し試験

アークパワーを 1.5 kW に固定した状態で、イオン 源に Cs を導入した結果を Figure 4 に示す. Cs 導入 器のバルブを開放する前のビーム電流は 4~5 mA で あるが、バルブを開放し Cs 導入器のヒーター温度を 上昇させるとビーム電流は増加し、16 mA に到達し た(Figure 4, Day 1). 16 mA 到達後、ビーム電流 は時間とともに減少するが、繰り返し Csを導入する ことでビーム電流は 18 mA まで増加し、その後の減 少の時定数は大きくなっていく様子が観察された (Figure 4, Day 2). PASJ2016 MOP052



Figure 4: H⁻ beam current with Cs injection (Arc power is 1.5 kW).



Figure 5: H⁻ beam current with Cs injection (Arc power is 2.5 kW).

アークパワーを 2.5 kW に維持した状態でのビーム トレンドを Figure 5 に示す. ビーム電流初期値は 21 mA であり, 2時間以上の連続引き出しが可能である ことを確認した. ビームの減少率は 2 時間で 1.4%で あり, アークパワーを微調整することでビーム電流 は一定に維持可能である.

5. まとめ

医療用陽子サイクロトロンの外部イオン源として 開発した水素負イオン源は、Csを導入しない状態で 最大 15 mA, Csを導入することにより 2.5 kW の低 アークパワーで 20 mA 以上の DC ビームを連続的に 引き出すことができた.今後の課題として、長時間 運転に必要なCs 消費量の把握、プラズマ電極温度の 最適化, Cs 導入器を含む自動制御系の構築に取り組み,より長時間の安定なビーム引き出しの実現を目指す.

参考文献

- [1] H. Etoh et al., Rev. Sci. Instrum. 87, 02B135 (2016).
- [2] M. Bacal et al., J. Appl. Phys. 52, 1247 (1981).
- [3] K. N. Leung, K. W. Ehlers and M. Bacal, Rev. Sci. Instrum. 54, 56 (1983).
- [4] Y. Okumura et al., Rev. Sci. Instrum 63 (1992) 2708.
- [5] Y. Mori *et al.*, Nucl. Instrum. Methods A **301** (1991) 1.
- [6] T. Morishita et al., Jpn. J. Appl. Phys. 40 (2001) 4709.
- [7] H. Etoh et al., Plasma and Fusion Res. 11, 2406063 (2016).